

Silizium-npn-Epitaxie-Planar-HF-Transistor für den Betrieb in Emitterschaltung

Für den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen.

Bauform 4 SOT23

Wärmewiderstand R_{thja}

auf Leiterplatte ($C_{eva} \geq 0,4 \text{ cm}^2$) $\leq 480 \text{ K/W}$
 auf Keramik $8 \times 10 \times 0,7 \text{ mm}$ $\leq 420 \text{ K/W}$

Grenzwerte

U_{CBO}	40	V
U_{CEO}	25	V
U_{EBO}	4	V
I_C	25	mA
P_{tot} (bei $\vartheta_a \leq 25^\circ\text{C}$)	300	mW
ϑ_j	150	$^\circ\text{C}$
ϑ_a	-55 ... +125	$^\circ\text{C}$

Statische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$)

I_{CBO} (bei $U_{CB} = 40 \text{ V}$)	\leq	500	nA
$U_{(BR)CEO}$ (bei $I_C = 1 \text{ mA}$)	\leq	25	V
$U_{(BR)EBO}$ (bei $I_E = 10 \mu\text{A}$)	\leq	4	V
h_{21E} (bei $U_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 1 \text{ mA}$)	\geq	40	

Dynamische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$)

C_{12e} (bei $U_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 1 \text{ mA}, f = 10,7 \text{ MHz}$)	\leq	0,6	pF
f_T (bei $U_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 1 \text{ mA}, f = 20 \text{ MHz}$)	typ.	390	MHz
F (bei $U_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 1 \text{ mA}, f = 200 \text{ KHz}$)	\leq	5	dB
$R_G = 300 \text{ Ohm}$		(typ)	1,6 dB

1) Messung erfolgt impulsmäßig